
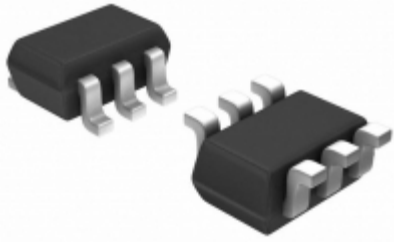
	<h2>SI1401EDH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1401EDH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1401EDH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37374 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1401EDH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37374 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 4A (Tc) 1.6W (Ta), 2.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta), 2.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 5.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 8V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1401EDH-T1-GE3CT

SI1401EDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1401EDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1401EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1401EDH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1402DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p>SI1402DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p>SI1402DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p>SI1402DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>
 <p>SI1400DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1400DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1403BDL Original QFN</p>	 <p>SI1400DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI1307DL-T1-E3	↔ SI1307DL-T1-GE3	⇒ SI1307DL-T1-GE3	D SI1307EDL	⇒ SI1307EDL-T1-E3
⊕ SI1307EDL-T1-E3	⊕ SI1307EDL-T1-GE3	D SI1307EDL-T1-GE3	⇒ SI1308EDL	⇒ SI1308EDL-T1-GE3
⊕ SI1308EDL-T1-GE3	⊕ SI13132CNU	⊕ SI1315DL-T1-GE3	↔ SI1315DL-T1-GE3	⇒ SI1317DL-T1-GE3
D SI1317DL-T1-GE3	⊕ SI1330EDL-T1-E3	⊕ SI1330EDL-T1-E3	⊕ SI1330EDL-T1-GE3	⇒ SI1330EDL-T1-GE3
⇒ SI1400DL-T1	↔ SI1400DL-T1-E3	⊕ SI1400DL-T1-E3	⊕ SI1400DL-T1-GE3	⇒ SI1400DL-T1-GE3
↔ SI1401EDH-T1-GE3	⇒ SI1402DH-T1-GE3	D SI1402DH-T1-GE3	⊕ SI1403BDL-T1-E3	⊕ SI1403BDL-T1-E3
⊕ SI1403BDL-T1-GE3	D SI1403BDL-T1-GE3	⇒ SI1403CDL-T1-GE3	↔ SI1403CDL-T1-GE3	⇒ SI1403DL
⊕ SI1403DL-T1	⊕ SI1403DL-T1-E3	↔ SI1403DL-T1-GE3	⇒ SI1404BDH-T1-E3	⇒ SI1404BDH-T1-E3
⊕ SI1404DH-T1	⊕ SI1404DH-T1-E3	⊕ SI1404DH-T1-GE3	D SI1404DL-T1-GE3	⇒ SI1405BDH-T1-E3
↔ SI1405BDH-T1-E3	⊕ SI1405BDH-T1-GE3	⊕ SI1405BDH-T1-GE3	⊕ SI1405DL-T1	⇒ SI1405DL-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited